## PRESENT STATUS OF THE PF INJECTOR

# Satoshi OHSAWA and the PF Injector Group National Laboratory for High Energy Physics (KEK) 1-1 Oho,Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305

### ABSTRACT

After construction of the PF 2.5-GeV linac and the Positron Generator Linac, continuous efforts have been made to improve performance of both linacs. The KEK B-Factory is presently under consideration as the TRISTAN phase-II future project. It requires 8-GeV electrons and 3.5-GeV positrons. The pre-injector has been upgraded in order to investigate instabilities induced by high intense electron beams in the main linac. Several developments, investigations and considerations are under way for the project. The present status of the PF injector linacs is described.

1. はじめに

PF 入射器の現状報告を仰せ付かり過去の報告例 を調べたところ、PF 入射器全体にわたる現状報告 は、本研究会では1980年の建設時期の1例だけで あった。活動が多岐にわたるため、1個の報告で 現状を網羅することが困難である、という事情が 背景にあったものと思われる。

KEKでは現在Bファクトリー計画の検討が本格 的に進められており、入射器であるリニアックに は、8GeVの電子ビームと強度のより強い陽電子 ビームが求められている[1]。この計画がスタート すると、リニアックはかつてない規模で改造され ることになる[2]。これに鑑み、現状の概要であっ ても現時点で整理しておくことは多少なりとも意 味があるかもしれない。とはいえ、PF入射器全体 を網羅するのは、筆者にはいささか荷が重過ぎる し、また適当であるとも思えない。従って、ここ で取り扱う範囲はかなりウエイトの片寄ったもの にならざるを得ないが、ご容赦いただきたい。

現状は過去に行われた改造や改良の集積である。 まずこれまでの経緯を概観し(表1参照)、後に 個別事項について説明する。PF 2.5 GeV リニアッ クは、4年間の建設期間の後1982年3月に完成し、 直ちにPFリングへの入射が開始された[3]。ひき続 いて陽電子発生装置の建設がスタートし85年に 完成[4].[5]、86年からはTRISTANの蓄積リング( AR)への定常的な陽電子入射が始まった。88年 にはPFリングにも陽電子ビームを供給する体制が 夏には整い、この年の12月から2種類の陽電子 ビームを切り換えて各リングに入射する運転が本

PF 入射器の現状

格的に開始された[6]。この年から92年にかけて 陽電子ビーム増強のために各種の改造が継続的に 行われた[7].[8]。また、Bファクトリーに向けて2.5 GeVリニアックで大電流の加速テストをすること が必要になり、92年の夏には入射部を全面的に 改造した[9].[10]。現在はBファクトリーの8GeV 電子加速に向て、クライストロン[11]とその電源 [12]及び加速管やSLEDの高電力.高電界試験 [13].[14]や、モニター系.トリガー系真空系等の各 種の試験や検討[15]が精力的に行われている。また 制御系の大幅な更新も現在進行中である[16]。

以下では、ビームや高周波源の運転状況、と各 種の改造を経た装置の現状等を中心にして報告す る。

表1 入射器のこれまでの経緯

| 1982,3月    | PF 2.5 GeV リニアック完成    |
|------------|-----------------------|
| 1985,3月    | 陽電子発生装置完成             |
| 1985,10月   | 2.5 GeV まで陽電子ビームを加速   |
| 1986       | ARへの本格的な入射開始          |
| 1987       | クライストロン改良             |
| 1988       | ミニ コンピュータMX 3000II 導入 |
| 1988       | モニター系改造               |
| 1988,7月    | PFリングの陽電子運転開始         |
| 1989,3月    | 陽電子発生装置入射部 r f 増強     |
| 1990-92,1月 | 陽電子集束系の改造             |
| 1990,4月    | PFリングの単バンチ運転開始        |
| 1991,3月    | テストリニアック完成            |
| 1991       | 低速陽電子発生プロジェクト開始       |
| 1992,夏     | 2.5 GeV リニアック入射部増強    |
| 1992 - 93  | 制御システムの更新             |
| 1992-93    | B-Factory 関係各種要素試験    |

-434 -

|        | eリニアック     | 陽電子発生装置          |
|--------|------------|------------------|
| 電子銃    |            |                  |
| 加速電圧   | 190 kV     | 150 kV           |
| 最大電流   | 10 A       | 10 A             |
| ビームエネル | ギー         |                  |
| 電子     | 2.5 GeV    | 250MeV           |
| 陽電子    |            | 250MeV           |
| 加速周波数  | 2856 MHz   | 2856 MHz         |
| 加速管    | 2/3πモード,進行 | <b>行波型、準定勾配型</b> |
|        | 2 m管 x 162 | 4m管x11+2m管x1     |
| クライストロ | <b>ン</b>   | 40+1台 6+1台       |
| パルス幅   | 3.5 µs     | 3.5 µs           |
| 繰り返し   | 25 (50) Hz | 25 (50) Hz       |
|        |            |                  |

表2 入射器の主な基本パラメータ

#### 2. 運転の状況

### 2.1 ビームの現状

現在営業運転で入射器から供給しているビーム は、電子/陽電子それぞれ2種類ずつである。AR は単バンチ運転であるから、パルス幅が1.5 ns の ビームのみであるが、PFリングは長パルス運転時 には40nsのビームを使用し、単バンチの場合には 1.5nsビームを使用している。尚、1 µs 幅の電子ビ ームは、現在では、リニアックのクライストロン の位相調整時にのみ使用している。

図1は近年のリニアック運転総時間と運転率を 示している[17]。年間5千時間以上運転しており、 故障率は平均で98%台である。

| 表3 | 2.5 GeVの名 | らビーム | とリ | ング | の蓄積率 |
|----|-----------|------|----|----|------|
|----|-----------|------|----|----|------|

| 加速粒子              | 電子     |        | 陽電子    | kennek anterpolitik interationale |
|-------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| パルス幅              | 1 μs,  | 1.5 ns | 40 ns, | 1.5 ns                            |
| ピーク電流             | 50 mA, | 0.4 A  | 2 mA,  | 40 mA                             |
| 供給先               | Linac, | AR     | PF,    | AR,PF                             |
| <b>蓄積率 (mA/s)</b> | _      | 2      | 1,     | 0.3                               |



図1 運転総時間と運転率

#### 2.2 クライストロン

図2は、クライストロンの運転状況を示してい る。近年とみに信頼性が向上してきた[17].[23].[24]。 この結果高周波電力に多少の余裕が出来、将来計 画に向けた諸々の実機試験が可能になった。



図2 クライストロンのFault Rateと印加電圧

### 3. モニター系の改良

1987年当時、陽電子ビームの調整には長時間を 要する上に、立ち上げ毎にビームの状態が異なる という問題があった。この状況を改善するために、 モニター系の整備が行われた[18]。陽電子発生装置 の一次電子ビーム部終端と2.5GeVリニアック終端 に運動量分析系を新設し、各分析系でスペクトル が自動で測定できるように整備した。また陽電子 発生装置と2.5GeVリニアックをつなぐビーム輸送 系のアクセプタンスを大きくすると同時に、関係 する部分のビームモニター系を改造し、運動量分 析系としての機能も改善した。

これらの整備により、陽電子ビームの運転が容 易になり、信頼性も上がって大電流電子ブームの 特性測定が行えるようになった。

#### 4. 陽電子ビームの増強

陽電子発生装置では、完成以来、陽電子ビーム 電流を増やすための努力が継続して払われてきた。 その主な内容は、以下のようなものである。

#### 4.1 一次電子ビームの集束系増強

電子銃の電流が次第に増加すると共に、電子ビ ーム径が大きくなり、ターゲットまでビームを損 出することなく加速することが困難になってきた。 そこでQ電磁石数をほぼ倍増して、アクセプタン スを大きくすることにより、ビームの透過率を改 善した。これにより、ターゲットに入射する一次 電子ビーム電流が増大した。

## 4.2 入射部の rf 増強

加速電流増加によりビーム負荷が深刻になり、 クライストロン&モジュレータ電源を1台入射部 に追加して ff を増強した。

#### 4.3 電子銃の改造

1988年の12月から、PFリングへの陽電子入射 が本格的に始まった。このビームは電荷量が大き くなるので、電子銃のカソードの寿命が問題とな ることが予想された。そこでカソードを Y-796 に 変更し、ビームの安定を計った[6]。

### 4.4 陽電子集束系の改造

1990年から2年間、陽電子の集束系のアクセプ タンスを倍増するための一連の工事を行った[7].[8]。 これにより、陽電子ビーム電流が倍増すると共に、 運転時の安定性と信頼性が増した。

表4 陽電子集束系の主な改造

| ·······                     | 改造前          | 改造後          |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Pulsed Solenoid             | 1.2T x 76 mm | 2.3 x 45 mm  |
| Pulse Power Supply          | 1 kV - 5 kA  | 4 kV - 20 kA |
| DC Solenoid                 | 0.2Tx4m      | 0.4 T x 8 m  |
| e /e <sup>+</sup> Separator |              | 4 B.M.       |
| Q-Mag System                | 8 Q-triplets | FODO+4 Q's   |

#### 5. テストリニアック

2.5 GeVリニアックの入射部の隣にある側室(長 さ20m余り)の入り口を、コンクリートブロッ クでシールドして建設された[19]。完成は1991年3 月である。リニアックで使用される部品などの要 素開発や試験のほか、営業マシンでは困難である 各種の研究開発を目的としている。

#### 6.制御系の改造

制御系計算機(MELCOM)の更新に伴い、シス テムの構成を大幅に改造している。ハードウェア の主要部分の置き換えを行うと共に、ソフトウェ アの構成も変更される[16]。

#### 7. 低速陽電子発生裝置

単色の低速陽電子を2.5 GeVリニアックの電子線 を用いて発生させ、クライストロンギャラリーま で導くためのビームラインの建設が、リニアック の終端部で現在進められている[20]。これは低速陽 電子の利用を推進するためのものである。

| 表5 低速陽電子源ビームの現状 |       |       |         |  |
|-----------------|-------|-------|---------|--|
| 1次電子            | 2 GeV | 25 Hz | 2 ns    |  |
| ビームパワー          |       | 8 W   |         |  |
| 低速陽電子ビーム強度      |       |       |         |  |
| 陽電子に起因する        | 線     | 10°個/ | sec/ kW |  |

#### 8. B-ファクトリー関係

KEKのB-ファクトリー計画は、8 GeV の電子 ビームと3.5 GeV 陽電子ビームを正面衝突させて、 CP vioration や素粒子間のmixing などを測定しよう というものである。沢山のイベントを必要とする 精密実験であるから、リング内に蓄積されるビー ムは必然的に大電流になり、数アンペアに達する。

従って、トリスタンの主リングを使用する現在 の案の場合には、蓄積電流が現状の百倍以上にな り、特に陽電子の入射時間つまり陽電子のビーム 強度が重要なポイントになる。また、リニアック からリングへ8 GeV の電子ビームを直接入射する ことになっているので、加速電界がもう一つの重 要課題である。現在 B-ファクトリー計画の実現 に向けて、以下に述べるような改造や試験及び検 討等が精力的に行われている[2]。

#### 8.1 入射部の改造[9]

昨年(1992年)の夏期保守期間中に2.5 GeV リ ニアックの入射部を大幅に改造し、大電流加速が できるようにした。これはB-ファクトリーに向 けた入射器改造の第1歩である。入射器改造案で は、陽電子ビームの10倍増強を1次電子ビーム のエネルギーを現在の250MeVから4GeV程度まで 引き上げることにより、実現しようとしている。 このためには、現在と同程度の大電流の電子ビー ムを、現在よりもはるかに長い距離にわたって加 速し、ターゲットまでロスなく導くことが重要で ある。従って、BBUなどの問題を現在の装置であ らかじめ調査しておくことが必要である。

図3は、改造後のビーム加速特性である。B-ファクトリーで必要とする10 nC程の電子ビームが 第二セクター中央までは特に問題なく加速された。 但しこれはsバンドの単バンチビームではない。 電荷量を大きくすると第1セクタ入り口でのロス が増加する。ビーム負荷によるエネルギー幅の増 加とウェークフィールドによるエミッタンス増大 が原因であると考えられる。入射部以外の殆どの 部分は、1982年の完成時のままで、トランスポー トのアクセプタンスは1µs/50mA のビームを想定し て設計されており、この部分のアクセプタンスが 最小になっている[21]。

今年の夏期保守期間中に、第1セクターの第1 ユニット中央にQ-tripletを1組追加し、アクセプタ ンスの最小部分を改善する。また476MHzのSHBを 導入して、Sバンドの単バンチ加速試験ができる ように、現在準備中である。



図3 入射部改造後の大電荷加速試験



図4 8A-4ns ビームのバンチ幅、FWHM 9.8 ps

8.2 SLEDの試験[14]

| 表6 SLEDの加速試験結果 |          |                 |  |
|----------------|----------|-----------------|--|
| クライストロ         | コン出力     | 28 MW           |  |
| 加速電界           | SLED off | 10.3 MV/m       |  |
|                | SLED on  | 19.4 MV/m (平均)  |  |
|                |          | 23.1 MV/m (ビーク) |  |
| エネルギー          | 曾倍率      | 1.9倍            |  |

8 GeV を達成するにはクライストロンの出力電 力を上げるだけでは十分でなく、何らかの方法で パルスを圧縮することが必要である。この1つの 方法がSLAC で開発されたSLEDである。PF リニ アックでは、JLCで開発したもの[22]を基本にして テスト用空洞を製作し、4 セクターの6 ユニット に実装して高電力試験を行っている。加速電界の 値は、ビームエネルギーの測定値から算出した値 である。

8.3 加速管の耐電圧試験[13]

既存の加速管がどの程度の高電圧に耐えられる かを見極めることは、B-ファクトリー計画の基 本方針に関わる重要課題である。クライストロン 1台分の全パワーを1本の2m還流型加速管に供 給して、加速官の耐電圧試験をした。

多数の加速管をタイミングを合わせた状態で試 験をしないと、電界放出電流の問題もあるので、 最終的な判断は難しいが、まずは第一段階をクリ アしたものと考えられる。

表7 加速管の耐電圧試験結果

| クライストロン出力      | 30 MW       |
|----------------|-------------|
| (4-8 unit,還流型) |             |
| 加速電界           | 28.6 MV/m   |
| running 試験     | 25~30MW,4ヵ月 |
| Timing         | Standby 状態  |
| rfoffの回数       | 数回          |

8.4 クライストロンのハイパワー化[11]

現在ライナックで使用しているクライストロン の絶縁碍子を大きくして印加電圧を高電圧化する とともに、集束磁場を強化した結果、310 KV の印 加電圧時に51 MWの出力パワーが得られた。

これで、既存のコンポーネントの多くを再利用 可能す方向で、ハイパワー化するめどが付いた。 但し、カソード面積を大きくし、単位面積当りの 電流密度を無理のない値にする等の改良を加える。

表8 ハイパワー化Kly.の試験条件と結果

| -       |         |        |  |
|---------|---------|--------|--|
| クライストロン | PV3030A | 改良型    |  |
| 印加電圧    | 265 kV  | 310 kV |  |
| 出力パワー   | 33 MW   | 51 MW  |  |
| パルス幅    |         | 4 µs   |  |
| 効率      |         | 44%    |  |
|         |         |        |  |

8.5 モジュレータの改造[12]

クライストロンの効率はほぼ一定であるから、 rfパワーを増やすにはパルス電源のパワーを増 やすことが必要になる。PFNのコンデンサーの 総数を2倍にして、パルス当りのエネルギーを2 倍にする改造を進めている。

PFN コンデンサー 20個 ---> 20個2組パラ 総容量 0.292 μF ---> 0.584 μF パルスエネルギー 295 J ---> 590J ピーク電力 105 MW パルス幅 (半値) 5.6 µs (平坦部) 3.3 µs クライストロン効率 (仮定) 44% 期待されるff出力パワー 46 MW

### 表9 モジュレータの改造

#### 8.6 モニター系

各種モニター系の検討や開発、テスト等が進め られている。ストリップライン型の位置モニター は、夏期保守期間中に第1セクター前半に4台設 置され、実機試験が始まる予定である[15]。

## 参考文献

- [1] 黒川真一, B-Factory Mini-Workshop, 1993年7月
- [2] 佐藤勇.,"入射器のエネルギー増強計画",本研 究会; A. Enomoto et al., "Linac Upgrade Plan for the KEK B-Factory", submitted to the 1993 Particle Accelerator Conference, Washington, D.C., 1993
- [3] J. Tanaka et al., "Operation of the KEK 2.5-GeV Electron Linac", Proc. of 1984 Linac Conf., Darmstadt, 1984, pp. 475-479
- [4] A. Asami et al., "Injector of the Positron Genarator", Proc. of 1986 Linac Conf., SLAC, pp. 496-489
- [5] I. Sato et al., "Accelrator Characteristics of Positron Generator Linac", Proc. of 1986 Linac Conf., SLAC, 1986, pp. 502-504
- [6] S. Ohsawa et al., "Positron Beams for the PF Storage Ring", Particle Accelerators, 1990, Vol 27, pp. 139-144
- [7] A. Enomoto et al., "Performance of the Upgraded Positron Generator at KEK", in Proceedings of the Third European Praticle Accelerator Conference, Hamburg, Germany, 1992
- [8] S. Ohsawa et al., "Improvements to the Positron Focusing System of the KEK Positron Generator and Its Performance", in Proceedings of the XVth Internatinal Conference on High Energy Accelerators, Hamburg, Germany, 1993, pp.135-137
- [9] S. Ohsawa et al., "New Pre-injector of the KEK 2.5-GeV Linac and its Performance", submitted to

the 1993 Particle Accelerator Conference, Washington, D.C., U.S.A., 1993; T. Kamitani et al. "A Simulation Study on Beam Bunching in the KEK 2.5-GeV Linac New Pre-injector", ibid.

- [10] Y. Ogawa et al., "Beam Monitor Utilizing Transition Radiation", ibid.
- [11] 道園真一朗ほか.,"Bファクトリー用46MWクラ イストロンの出力試験 ",本研究会
- [12] 本間博幸ほか.,"Bファクトリーのための46MW クライストロン用増強パルス電源 ",本研究会
- [13] 大越隆夫ほか.,"レゾナントリングによる 2 m 加速官の実験 ", 本研究会
- [14] 花木博文ほか,,"パルス圧縮法によるPFリニアック 高周波源の増強",本研究会
- [15] 諏訪田剛ほか.,"電子/陽電子ライナック用ビ ーム位置モニターの開発(II) ", 本研究会
- [16] 古川和朗ほか.,"制御系の構成について"; 上窪 田紀彦ほか.,"KEK-Linac 新制御システム "; 阿 部勇、中原和夫ほか.,"PCによる大型加速器( PF 2.5 GeV Linac)制御の試み ", 本研究会
- [17] Photon Factory Activity Report 1987 ~ 92
- [18] T. Shidara et al., "Improvements to the Monitoring System of the KEK 2.5-GeV Linac and its Performance Tests", Particle Accelerators 29. pp. 239-244 (1990)
- [19] H. Kobayashi et al., "Present Status of Test Linac at Photon Factory, KEK ", in Proc. of the 16th Linear Accelerator Meeting in Japan, 1991, p.10-12
- [20] 白川明弘ほか, "PF低速陽電子源", 本研究会; 浅見明ほか, "フォトン.ファクトリー2.5 GeV 電子線形加速器を用いた低速陽電子源の建設 計画", 放射線Vol.18, No. 2, 1992, pp. 35-39
- [21] 紙谷琢哉、私信
- [22] H. Matsumoto et al., "High power test of a SLED system with dual side-wall coupling irises for linear colliders", Nuclear Instruments and Methods A330(1993)1-11
- [23] 松田七美男ほか, "放射光入射器線形加速器マ イクロ波源の現状", 第13回リニアック研究 会、1988, pp. 44-42
- [24] 本間博幸ほか, "PFライナック大電力パルス電 源PFN用コンデンサーの故障と改善", 第14回 リニアック研究会、1989, pp. 294-296

-438 -